

⑭ 半導体の静電気破壊防止回路

① 実 願 昭46-50582

② 出 願 昭46(1971)6月14日

③ 考 案 者 角田道夫

名古屋市千種区大久手町7の1

新白砂電機株式会社内

④ 出 願 人 新白砂電機株式会社

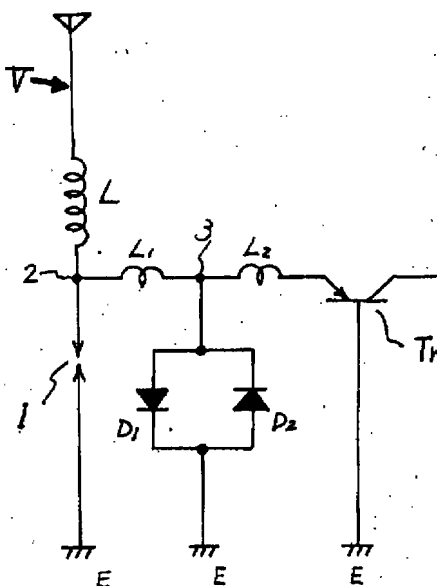
名古屋市千種区大久手町7の1

⑮ 実用新案登録請求の範囲

半導体のアンテナ入力回路と、アース間に、放電ギャップ及び互に逆方向にした2個のダイオードを接続し、入力回路側の放電ギャップ接続点と、ダイオード接続点の間、及びダイオード接続点と、半導体入力端子の各間に微少インダクタンスを持たせる様にした半導体の静電気破壊防止回路。

図面の簡単な説明

図は本案半導体の静電気破壊防止回路の構成を示す回路図である。



(Citation 19)

JP Utility Model Appl. Discl. No. 48-9039 - February 01, 1973

Application No. 46-50582 - June 14, 1971

Applicant: SHINSHIRASUNA ELECTRIC CORP, Aichi, (JP)

Title: ELECTROSTATIC DISCHARGE FAILURE PREVENTION CIRCUIT OF SEMICONDUCTOR

[Detailed Description of the Utility Model]

.....

If an object built up with static electricity touches the antenna circuit, most of the electric charge (V) avoids the inductance (LI) having high resistance to a pulse, and is discharged between the grounds via the discharging gap (I), causing a large voltage drop. At the same time, the remaining electric charge flows between the grounds through the inductance (LI) and the diode (DI) or (D2) to disappear. Therefore, no current flows into the semiconductor (Tr), and destruction will not occur. The inductance (L2) is disposed in order to prevent a remaining electric charge from flowing into the semiconductor.

.....